

2017年5月12日
一般社団法人 新金属協会
化合物半導体部会
部会長 三浦 浩
JX 金属株式会社
電材加工事業本部 薄膜材料事業部
化合物半導体ユニット ユニット長

平成 28 年度通期の化合物半導体の出荷統計について

2016 年度通期（2016 年 4 月～2017 年 3 月）の化合物半導体材料の出荷統計がまとまりましたので別紙の通り発表いたします。

2016 年度通期（2016 年 4 月～2017 年 3 月）の化合物半導体製品の出荷額は、243 億円となりました。結晶別では、主要 3 品目のうち InP、GaP が増加した一方で、GaAs が減少しました。用途別では LD 増加した一方で、可視 LED が微減、赤外 LED とその他が減少しました。

1.GaAs

2016 年度通期の GaAs の売上高は、154 億円となり、国内、海外ともに減少しました。GaAs の主な用途市場はスマートフォン等に使用される高周波デバイス、また各種の表示機器やセンサ等に使用される可視・赤外 LED、および光ディスク等に使用されるレーザダイオード (LD) 等がありますが、2016 年度の結果は主に光ディスク市場の縮小と可視・赤外 LED の減少によるものと推察しています。

2.GaP

2016 年度通期の GaP の売上高は、21 億円となり、国内、海外ともに増加しました。可視 LED 用途市場の需要落ち込みの影響や GaP 系および GaAsP 系 LED が車載、家電等の特定市場へ絞り込まれていく傾向は続いているものの、安価で高輝度な中国製 AlInGaP 系や供給過剰になっている GaN 系 LED への置き換えのスピードがやや緩やかになってきているものと推察しています。

3.InP

2016 年度通期の InP の売上高は、58 億円となり、国内、海外ともに増加しました。昨今の通信量の増大を背景に、InP の主要な用途である光通信用の受発光素子の所要が堅調に推移した結果と推察しています。

<お問い合わせ先>

電材加工事業本部 薄膜材料事業部
化合物半導体ユニット 主席技師
中村 正志
電話 03-6257-7417 Fax 03-6213-3609
e-mail : nakamura.masashi.384@jxgr.com